

便簽 日期：
單位：研究發展處

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

學術發展組擬辦：

- 一、公告於學校首頁最新消息及本處訊息公告，並email副知全校教研人員知照。
- 二、如欲請校長推薦申請者，請填寫校內推薦表(如附檔)並完成校內推薦程序後，併同申請資料(紙本，請勿裝訂)於2026年1月9日(五)下午5時前送達研發處學術組彙整，俟簽請校長同意推薦後，辦理申請資料與推薦書紙本函送及電子檔電郵傳送。
- 三、文陳閱後存查。

會辦單位：

第二層決行	承辦單位	會辦單位	決行
 114.11.27    研究發展處 宋振銘(乙)			

財團法人潘文淵文教基金會 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：曾郁玳

電話：03-5913681

E-mail：yuchia@itri.org.tw



1140023051001

402 臺中市南區興大路 145 號

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國 114 年 11 月 19 日

發文字號：工研潘字第 1140023051 號

速別：普通件

密等：無

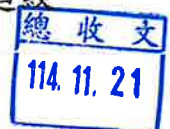
附件：無

主旨：檢送本會 2026 年度「胡正明半導體創新獎」獎勵辦法及申請書乙份，請惠予公布並協助推薦優秀人員參選。

說明：

- 一、為表揚國內半導體相關領域，從事研究工作有卓越成績之 55 歲以下研究人員，具備國際級水準卓越表現之優秀人士，本會自 2024 年起舉辦「胡正明半導體創新獎」選拔活動。
- 二、「胡正明半導體創新獎」得獎者將獲得頒發獎金每名新台幣拾萬元及獎章乙面。名額共計二名，「半導體元件、材料與製程創新獎」及「半導體產品設計與應用創新獎」各一名。本基金會自即日起接受申請至 2026 年 01 月 15 日截止，請惠予公布並協助推薦優秀人員參選；「胡正明半導體創新獎」評審辦法及申請書格式刊載於本基金會網站，網址為：<https://pan.itri.org.tw/>，敬請瀏覽並下載。
- 三、申請文件請檢附紙本申請書乙份（請勿裝訂，請使用迴紋

國立中興大學



附台本校『文書處理要點』第18條、
33條規定，以紙本公文辦理。



1140055322

針或長尾夾固定即可)，寄至 310401 新竹縣竹東鎮中興
路四段 195 號 51 館 1030-1 室 潘文淵文教基金會曾郁珈
小姐收；另請同步將電子檔寄至 yuchia@itri.org.tw。

正本受文者：國立中興大學

財團法人潘文淵文教基金會



財團法人潘文淵文教基金會
胡正明半導體創新獎 獎勵辦法

民國一一二年十月二十日 本會第十屆第二次董事會訂定

一、目的

財團法人潘文淵基金會（以下簡稱本會）為獎勵國內半導體相關領域，具備國際級水準卓越表現之優秀人士，特訂定本辦法；本獎項為胡正明院士獲得之「總統科學獎」獎金 200 萬元捐贈給潘文淵文教基金會做為獎金來源，特命名為「胡正明半導體創新獎」。

二、獎勵名額及評審條件

每年辦理一次，「半導體元件、材料與製程創新獎」及「半導體產品設計與應用創新獎」各一名，共計二名。得獎者需具有國際水準，由評審委員從寬解讀，以國內最佳創新為基本條件。如果評審委員認為國內最佳申請人並未參與申請，得請評審委員以個人名義鼓勵最佳申請人於下一年度提出申請。

三、申請資格

- （一）國內從事研究工作有卓越成績之 55 歲以下研究人員。
- （二）已得本會任何獎項者，本創新獎不再為同一件創新受理申請。
- （三）申請人得同時申請「半導體元件、材料與製程創新獎」與「半導體產品設計與應用創新獎」。

四、申請程序

- （一）由下列機構或個人推薦有關政府機關、學校有關企業團體或企業有關學術研究機構或團體有關人士。
- （二）推薦人應提供資料，格式如附件，於申請期限內寄/傳達本會。

五、評審作業

（一）評審程序

初審：由本會工作小組進行資格審查。

複審：由本會聘請相關領域之技術專家進行書面審查。

決審：由評審委員會就複審時之專家意見進行審議，並決定得獎名單。

（二）評審委員會

由本會聘請學者、專家五至七人擔任委員，任期三年，並推舉一人擔任召集人。

六、頒獎表揚

- (一) 頒發獎章及新台幣 10 萬元獎金，並於每年四月舉行之 VLSI TSA 國際研討會中公開表揚。
- (二) 得獎人應親自出席，若不克領獎，則本基金會保留其獎金做為與本會相關活動之權利。

七、本辦法經本會之董事會通過後實施，修正時亦同。